



T3STER SI Rth Measurement

- How to Measure Rth of GaN HEMT -



-  Angel Chen
-  PID 精密儀器事業部
-  angel@flotrend.com.tw
02-27266269 Ext:223



Simcenter T3STER SI Introduction

■ 用途:

- 熱阻量測設備
- 適用大部分半導體元件與模組 (Diode、MOSFET、IGBT...)

■ 特點:

- 符合 JEDEC 國際標準規範
- 電流切換速率：1 μ s
- 數據最快擷取速率：1 sample/ μ s
- 可透過結構函數判斷元件結構受損區域，行非破壞性失效分析
- 可依客戶需求進行設備客製化配置與擴充
- 可結合熱模擬軟體 FloTHERM Calibration

■ 可搭配多種增壓穩壓系統加輸出大功率

- ✓ Booster 240A / 11V
- ✓ Booster 10A / 150V
- ✓ Booster 50A / 30V



Simcenter T3STER SI



欲知詳情，請加入勢流會員 即可每月收到會員電子報

會員電子報請至客戶專區→會員專屬月刊 觀看完整內容



Thank You For Attending

謝謝您的參與



- Angel
- angel@flotrend.com.tw
- 02-27266269 EXT.223
- PID精密儀器事業部/產品工程師
- 台北市信義區忠孝東路五段550號13樓

